



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
27.10.1999 Patentblatt 1999/43

(51) Int. Cl.⁶: G05F 3/30

(21) Anmeldenummer: 99105492.5

(22) Anmeldetag: 17.03.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

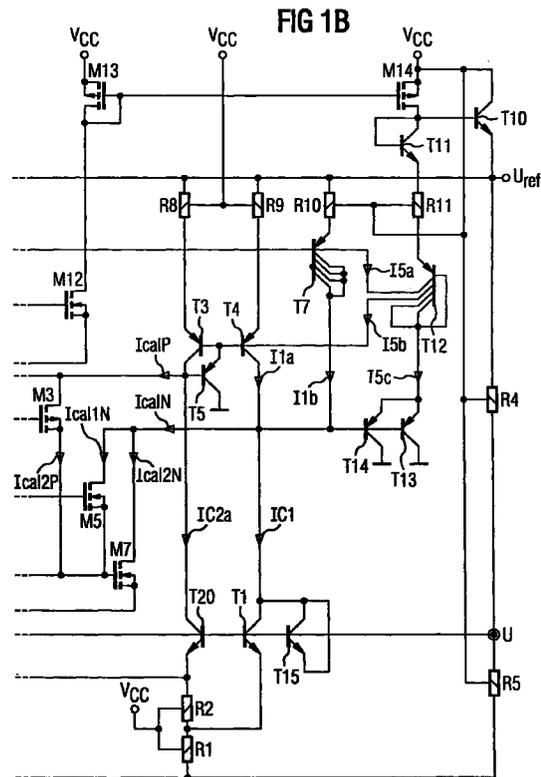
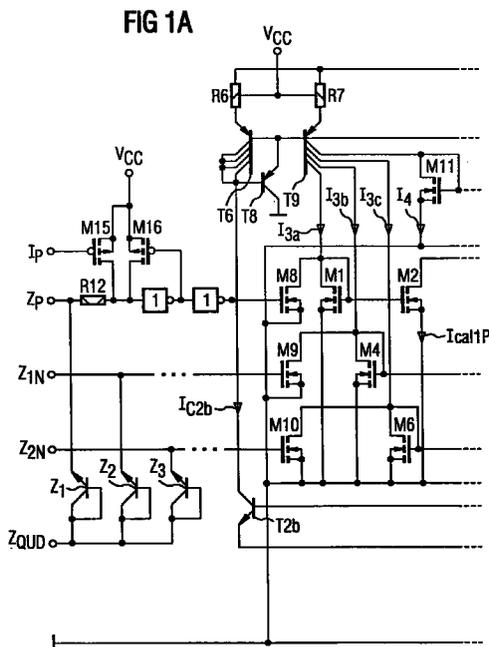
(71) Anmelder:
**SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)**

(72) Erfinder: **Wachter, Franz, Dr.
9504 Villach (AT)**

(30) Priorität: 21.04.1998 DE 19817791

(54) **Referenzspannungsschaltung**

(57) Referenzspannungsschaltung, wobei von einer Bipolartransistorschaltung (T1, T2a, T2b) eine Referenzspannung (U_{ref}) geliefert wird, welche einer Summenspannung aus der Flußspannung eines stromdurchflossenen pn-Übergangs und einer Differenzspannung zweier Flußspannungen von mit unterschiedlichen Stromdichten betriebenen pn-Übergängen entspricht. Die Referenzspannungsschaltung umfaßt Abgleichmittel (Z1-Z3, M1-M10), mit deren Hilfe Kollektorströme (IC1, IC2a) der Bipolartransistorschaltung (T1, T2a, T2b) verändert werden können. Dies wird insbesondere dadurch erreicht, daß das Spiegelungsverhältnis einer für die Bipolartransistorschaltung vorgesehenen Stromspiegelschaltung (T3-T5) verfälscht wird.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Referenzspannungsschaltung, insbesondere eine Referenzspannungsschaltung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, welche eine abgleichbare Referenzspannung liefert.

[0002] Integrierte Schaltungen, die nicht aus einer stabilisierten Versorgungsspannung betrieben werden, benötigen intern eine Referenzspannungsquelle. Dies gilt insbesondere für Spannungsregler, deren Ausgangsspannung anderen integrierten Schaltungen oder Schaltungsblöcken als Referenzspannung dient.

[0003] Im Prinzip kann die Durchlaß- oder Flußspannung einer Diode oder allgemein eines pn-Übergangs, z. B. die Basis-Emitter-Spannung eines Bipolartransistors, als Referenzspannung verwendet werden. Allerdings besitzt die Flußspannung eines pn-Übergangs einen negativen Temperaturkoeffizienten, der sich für viele Anwendungen negativ auswirkt. Sollen beispielsweise mit Hilfe eines Spannungsreglers, dessen Ausgangsspannung als Referenzspannung dient, Sensoren, A/D-Wandler oder ähnliche Bauteile versorgt werden, muß die Ausgangsspannung des Spannungsreglers hochgenau und insbesondere äußerst temperaturstabil sein.

[0004] Daher werden bevorzugt Bandgap- oder Bandabstands-Referenzspannungsschaltungen als Referenzspannungsquellen eingesetzt, die eine temperaturstabilisierte Referenzspannung liefern. Diese bekannten Bandgap-Referenzspannungsquellen basieren auf einer Addition einer Flußspannung eines stromdurchflossenen pn-Übergangs und einer mit einem entsprechenden Faktor multiplizierten Differenzspannung, die aus zwei Spannungen von zwei mit unterschiedlichen Stromdichten durchflossenen pn-Übergängen gebildet wird. Allgemein hat die Flußspannung eines stromdurchflossenen pn-Übergangs - wie bereits zuvor erläutert worden ist - einen negativen Temperaturkoeffizienten. Die Differenz zweier Flußspannungen steigt hingegen proportional zur absoluten Temperatur an und unterliegt damit einem positiven Temperaturkoeffizienten. Wird der Faktor, mit dem die zuvor erläuterte Differenzspannung multipliziert wird, derart eingestellt, daß sich der negative Temperaturkoeffizient der Flußspannung des pn-Übergangs mit dem positiven Temperaturkoeffizienten der Differenzspannung aufhebt, kann eine temperaturstabilisierte Ausgangs- bzw. Referenzspannung erhalten werden. Insbesondere beträgt die Ausgangsspannung einer derartigen Referenzspannungsquelle, welche durch Addition der zuvor erläuterten Flußspannung eines stromdurchflossenen pn-Übergangs mit der ebenfalls zuvor erläuterten Differenzspannung erhalten wird, ca. 1,25V, was in etwa dem Bandabstand (Bandgap) von Silizium entspricht. Daher werden derartige Referenzspannungsquellen als Bandgap-Referenzspannungsquellen bezeichnet.

[0005] Figur 2 zeigt ein verallgemeinertes Schaltbild einer bekannten Bandgap-Referenzspannungsquelle. Über eine Stromquelle I_0 , die einen eingepprägten Strom I_{Bias} liefert, ist eine Stromspiegelschaltung an einen positiven Versorgungsspannungsanschluß V_{CC} angeschlossen. Die Stromspiegelschaltung umfaßt zwei Widerstände R3 sowie Bipolartransistoren T16-T21. Die Stromspiegelschaltung erzeugt Ausgangsströme I_{C1} und I_{C2} , welche den gemäß Figur 2 verschalteten npn-Bipolartransistoren T1 bzw. T2 zugeführt werden. Die Basisanschlüsse der beiden Transistoren T1 und T2 sind miteinander verbunden, wobei die Basisspannung U des Transistors T1 über einen Spannungsteiler bestehend aus zwei Widerständen R5 und R4 hochmultipliziert wird, so daß am Widerstand R4 eine gewünschte Ausgangs- bzw. Referenzspannung U_{ref} abgegriffen werden kann. Mit dem Ausgangsanschluß dieser Referenzspannungsschaltung ist ein Transistor T10 gekoppelt, dessen Aufgabe es ist, die Ausgangsspannung U_{ref} auf einen konstanten Wert zu regeln, falls der Ausgang der in Figur 2 gezeigten Bandgap-Referenzspannungsquelle mit einer ungleichmäßigen Last belastet wird. Anstelle des Transistors T10 kann jedes beliebige Stellglied, beispielsweise ein Operationsverstärker oder ein MOS-Feldeffekttransistor, eingesetzt werden, welches die zuvor erläuterte Regelungsaufgabe übernehmen kann.

[0006] Mit Hilfe des in Figur 2 gezeigten Stromspiegels T16-T21 werden die durch die Transistoren T1 bzw. T2 fließenden Ströme eingestellt, wobei die Ströme I_{C1} und I_{C2} üblicherweise gleich groß sind. In BICMOS- oder BICDMOS-Schaltungen wird jedoch der Strom I_{C1} häufig auch auf einen vielfachen Wert des Stroms I_{T2} eingestellt. Die Transistoren T1 und T2 besitzen unterschiedliche Emitterflächen, wobei die Emitterfläche des Transistors T2 einem Vielfachen der Emitterfläche des Transistors T1 entspricht, so daß entsprechend die Emitterstromdichte des Transistors T1 einem Vielfachen der Emitterstromdichte des Transistors T2 entspricht.

[0007] Am gemeinsamen Basisanschluß der Transistoren T1 und T2 wird die Summenspannung aus der Basis-Emitter-Spannung des Transistors T1 sowie der an einem Knotenpunkt zwischen Widerständen R1 (bestehend aus den Teilwiderständen R1a und R1b) und R2 anliegenden Spannung abgegriffen. Die erstgenannte Basis-Emitter-Spannung des Transistors T1 entspricht der Flußspannung eines stromdurchflossenen pn-Übergangs und weist daher - wie zuvor erläutert worden ist - einen negativen Temperaturkoeffizienten auf. Die an dem Widerstand R1 bzw. an den Widerständen R1a und R1b abfallende Spannung ist abhängig von der Differenz zwischen der Basis-Emitter-Spannung des Transistors T1 und der Basis-Emitter-Spannung des Transistors T2 und besitzt - wie ebenfalls zuvor erläutert worden ist - einen positiven Temperaturkoeffizienten. Durch entsprechende Wahl der Widerstände R1 und R2 sowie der zuvor angegebenen

Beziehung zwischen den Emitterflächen der Transistoren T1 und T2 kann die in Figur 2 gezeigte Bandgap-Referenzspannungsquelle derart dimensioniert werden, daß die am Widerstand R1 anliegende Differenzspannung aus den Flußspannungen der beiden Transistoren T1 und T2 einem den negativen Temperaturkoeffizienten kompensierenden positiven Temperaturkoeffizienten unterliegt. In diesem Fall liegt an dem gemeinsamen Basisanschluß der Transistoren T1 und T2 die gewünschte temperaturstabilisierte Bandgap-Referenzspannung von ca. 1,25V an, die über den Teiler mit den Widerständen R4 und R5 hochmultipliziert wird.

[0008] Bandgap- bzw. Bandabstands-Referenzspannungsschaltungen der in Figur 2 gezeigten Art werden beispielsweise in der BICDMOS-Technologie (Bipolar, C- und D-MOS-Technologie) für präzise Spannungsregler verwendet. Derartige Referenzspannungsschaltungen sind auf einen relativen Fehler von maximal $\pm 1\%$ im Temperaturbereich von $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ spezifiziert, so daß eine entsprechende Kalibrierung bzw. ein Abgleich der Referenzspannungsschaltung vorzusehen ist. Um dabei Fertigungsstreuungen möglichst gering zu halten, wird während der Fertigung jedes System einzeln auf den gewünschten Spannungswert abgeglichen.

[0009] Referenzspannungsschaltungen der in Figur 2 gezeigten Art werden häufig auf Chips eingesetzt, die neben normalen Schaltreglern auch Leistungsschalter beinhalten. Dies gilt beispielsweise insbesondere für Automobilanwendungen. Diese Leistungstransistoren werden von integrierten Temperatursensoren überwacht, die ihrerseits eine temperaturstabile Spannungsreferenz benötigen, um im gewünschten Hochtemperaturbereich von $250\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Transistorkerntemperatur) noch sicher dynamisch schalten zu können. Berücksichtigt man den thermischen Gradienten an dem jeweils verwendeten Chip, kann davon ausgegangen werden, daß die verwendete Bandabstands-Referenzspannungsschaltung bis zu einer Temperatur von $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ möglichst temperaturstabil funktionsfähig sein muß bzw. im erweiterten Temperaturbereich einen relativen Fehler von maximal $\pm 2,5\%$ nicht überschreiten darf.

[0010] Dem wirken jedoch thermische Sperrschicht-Leckströme entgegen, welche ab ca. $140\text{ }^{\circ}\text{C}$ einsetzen und mit steigender Temperatur exponentiell zunehmen. Daher besteht das Bedürfnis, den Einfluß der thermischen Sperrschicht-Leckströme auf die von der Referenzspannungsschaltung gelieferte Referenzspannung zu minimieren. Wie bereits zuvor erläutert worden ist, sind in der Regel Möglichkeiten zur Kalibrierung oder zum Abgleichen der Ausgangsspannung der Referenzspannungsschaltung vorgesehen. In derartigen Abgleichschaltungen treten jedoch ebenfalls Leckströme auf, die üblicherweise einen großen Einfluß auf die Temperaturstabilität der Referenzspannungsschaltung insbesondere bei hohen Temperaturen ausüben. Dies soll nachfolgend näher anhand Figur 3 erläutert

werden.

[0011] Der Abgleich der von der Referenzspannungsquelle gelieferten Referenzspannung erfolgt üblicherweise durch Umschalten des in Figur 2 gezeigten Teilverhältnisses $R1:R2$, was durch entsprechend parallel zu schaltende Widerstände realisiert werden kann. In Figur 3 ist beispielhaft eine entsprechende an die in Figur 2 gezeigten Widerstände R1a und R1b angeschlossene Abgleichschaltung dargestellt, wobei als Abgleichschalter sogenannte "Zapping"-Dioden verwendet werden, die beim Anlegen einer hohen äußeren Spannung in Sperrichtung durchbrechen und eine niederohmige Verbindung erzeugen. In Figur 3 ist eine derartige "Zapping"-Diode in Form eines npn-Bipolartransistors T22 dargestellt, die durch Anlegen einer entsprechend hohen Abgleichspannung an die Anschlüsse Z_{1N} und Z_{GND} zum Durchbruch in Sperrichtung gebracht werden kann. In diesem Fall wird der Widerstand R1a infolge des Durchbrechens der in dem Bipolartransistor T22 ausgebildeten Diode kurzgeschlossen und somit der Gesamtwiderstandswert des Widerstands R1, der gemäß Figur 2 und 3 aus den Widerständen R1a und R1b besteht, verändert. Die Veränderung des Teilverhältnisses der Widerstände R1 und R2 wirkt sich unmittelbar auf die an dem Knotenpunkt zwischen den Widerständen R1 und R2 anliegende Differenzspannung der Basis-Emitter-Spannungen der Bipolartransistoren T1 und T2 (vgl. Figur 2) aus, so daß durch eine entsprechende Veränderung dieses Teilverhältnisses $R1:R2$ die an der Basis des Transistors T1 anliegende Spannung und damit die von der Referenzspannungsquelle ausgegebene Referenzspannung U_{ref} eingestellt bzw. abgeglichen werden kann.

[0012] Da der die "Zapping"-Diode bildende Transistor T22 eine in Figur 3 durch eine Diode D1 angedeutete Sperrschicht zum Substrat aufweist (Sperrschichtisolation), treten insbesondere bei hohen Temperaturen Kollektor-Substrat-Leckströme I_{sub22} (bzw. bei nach dem Abgleich nicht kurzgeschlossenen Dioden Kollektor-Basis-Leckströme) auf, die das Teilverhältnis $R1:R2$ und somit die Ausgangsspannung U_{ref} verfälschen. Des weiteren sind für derartige Abgleichschaltungen Spannungsklemmschaltungen erforderlich, um die Schaltung vor den während der Kalibrierung an den Abgleichanschlüssen auftretenden hohen Spannungen zu schützen. Eine derartige Spannungsklemmschaltung ist in Figur 3 mit einer Diode D3, einem Transistor T23 und einem Widerstand R13 dargestellt. Auch der Kollektor des Transistors T23 besitzt eine durch eine Diode D2 in Figur 3 angedeutete Sperrschicht zum Substrat, so daß auch bezüglich dieses Transistors T23 insbesondere bei hohen Temperaturen Kollektor-Substrat-Leckströme I_{sub23} auftreten, d. h. durch die zum Schutz der Abgleichschaltung vor den hohen Abgleichspannungen vorgesehene Spannungsklemmschaltung wird der zuvor beschriebene Leckstromeffekt sogar noch verstärkt.

[0013] Somit kann die in Figur 3 gezeigte Schaltung ab Temperaturen von ca. 160 °C nicht mehr mit der erforderlichen Genauigkeit betrieben werden. Ein weiterer Nachteil dieser Schaltung ist der endliche Widerstand der "Zapping"-Diode nach deren Durchbruch, da dieser Widerstand seriell zum eigentlichen Abgleichwiderstand geschaltet und somit ebenfalls die Ausgangsspannung ungewünscht verfälscht.

[0014] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Referenzspannungsschaltung zu schaffen, die zwar abgeglichen werden kann, d. h. bei der die gelieferte Referenzspannung zumindest innerhalb gewisser Grenzen eingestellt werden kann, wobei dennoch ein Betrieb der Referenzspannungsschaltung auch bei relativ hohen Temperaturen mit ausreichender Genauigkeit möglich ist.

[0015] Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden Erfindung durch eine Referenzspannungsschaltung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die Unteransprüche beschreiben vorteilhafte und bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, die ihrerseits zu einer verbesserten Temperaturstabilität der Referenzspannungsschaltung beitragen.

[0016] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die Referenzspannungsschaltung durch Verändern des Kollektorstroms mindestens eines Bipolartransistors des die Referenzspannung liefernden Schaltungsteils abgeglichen. Werden die Kollektorströme der beiden Bipolartransistoren des die Referenzspannung liefernden Schaltungsteils verändert, kann die Ausgangsspannung der Referenzspannungsschaltung ausgehend von einem voreingestellten Wert sowohl nach oben als auch nach unten verstellt werden.

[0017] Gemäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung erfolgt insbesondere der Abgleich durch Verziehen, d. h. Verfälschen, des Umsetzungsverhältnisses des Stromspiegels der Referenzspannungsschaltung. Durch Anlegen entsprechender Abgleichspannungen an Abgleichanschlüsse der Referenzspannungsschaltung können steuerbare Schalter, insbesondere in Form von MOS-Feldeffekttransistoren, aktiviert werden, so daß im geschlossenen Zustand dieser Schalter ein bestimmter Strom von den Kollektorstrompfaden zwischen dem Stromspiegel und den beiden Bipolartransistoren abgezweigt wird. Insbesondere umfaßt die Referenzspannungsschaltung mehrere Abgleichanschlüsse, die derart mit steuerbaren Schaltern verbunden sind, daß bei Anlegen einer Abgleichspannung an die einzelnen Abgleichanschlüsse unterschiedliche Ströme von den zuvor erwähnten Kollektorstrompfaden abgezweigt werden, so daß durch Aktivierung unterschiedlicher Anschlüsse unterschiedliche Einstellungen der Referenzspannung möglich sind.

[0018] An einer erfindungsgemäßen Testschaltung durchgeführte Messungen am Silizium haben beispielsweise einen Temperaturgang der von der Referenzspannungsschaltung gelieferten Referenzspannung

von $\pm 0,72\%$ im Temperaturbereich von -40 °C bis $+225\text{ °C}$ ergeben, wobei ein Abgleich der Referenzspannung wunschgemäß in einem Bereich $\pm 3\%$ durchgeführt werden konnte. Wird von einer Grundgenauigkeit nach dem Abgleich von $\pm 0,5\%$ ausgegangen, beträgt der während der Fertigung zu erwartende Gesamtfehler in dem zuvor beschriebenen Temperaturbereich weniger als $\pm 1,5\%$.

[0019] Die abgleichbare Referenzspannungsquelle der vorliegenden Erfindung eignet sich somit insbesondere für Hochtemperaturapplikationen von integrierten Schaltungen, wie z. B. für integrierte Spannungsregler, A/D-Wandler oder Meßschaltungen, die mit Hilfe von BICMOS-Prozessen hergestellt werden. Da mit Hilfe der vorliegenden Erfindung sämtliche Leckströme mit Hilfe eines geringen schaltungstechnischen Aufwands ausgeregelt werden können, ist die Bereitstellung der gewünschten Bandgap-Referenzspannung mit hoher Genauigkeit und Temperaturstabilität selbst bei Arbeitstemperaturen bis 250 °C möglich.

[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert.

Figur 1 zeigt ein detailliertes Schaltbild eines bevorzugten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Referenzspannungsschaltung,

Figur 2 zeigt ein Schaltbild einer bekannten Referenzspannungsschaltung, und

Figur 3 zeigt ein Schaltbild einer bekannten Abgleichschaltung, die zum Abgleichen der in Figur 2 gezeigten Referenzspannungsschaltung eingesetzt wird.

[0021] Bei der vorliegenden Erfindung wird weiterhin das anhand Figur 2 erläuterte Prinzip der Referenzspannungsgewinnung angewendet, d. h. die Referenzspannung wird durch Addieren einer Flußspannung eines stromdurchflossenen pn-Übergangs mit einer Differenzspannung zweier unterschiedlicher Flußspannungen von entsprechenden stromdurchflossenen pn-Übergängen gewonnen. Insbesondere werden in Übereinstimmung mit Figur 2 weiterhin in dem die Referenzspannung erzeugenden Spannungsteil zwei Bipolartransistoren T1 und T2 verwendet, deren Kollektoren bestimmte Kollektorströme I_{C1} bzw. I_{C2} zugeführt werden. Die Basisanschlüsse der beiden Transistoren sind miteinander verbunden, während die Emitter der beiden Transistoren über eine Widerstandsschaltung miteinander gekoppelt sind (vgl. Figur 2). An dem gemeinsamen Basisanschluß der Bipolartransistoren T1 und T2 wird - wie bereits anhand Figur 2 erläutert worden ist - die Referenzspannung abgegriffen und gegebenenfalls über einen Spannungsteiler hochmultipliziert. Die an der Basis des Bipolartransistors T1 anliegende Spannung setzt sich aus der Basis-Emitter-

Spannung des Bipolartransistors T1 und der am Knotenpunkt zwischen den Widerständen R1 und R2 anliegenden Spannung zusammen. Die letztgenannte Spannung ist von der Differenzspannung zwischen den Basis-Emitter-Spannungen der beiden Bipolartransistoren T1 und T2 abhängig. Durch geeignete Dimensionierung der Spannungsreferenzschaltung kann erzielt werden, daß der positive Temperaturkoeffizient der Differenzspannung dem negativen Temperaturkoeffizient der Basis-Emitter-Spannung des Bipolartransistors T1 entspricht, so daß an der gemeinsamen Basis der Bipolartransistoren T1 und T2 die gewünschte temperaturstabilisierte Bandgap-Referenzspannung mit ca. 1,25V abgegriffen werden kann.

[0022] Wie bereits anhand Figur 2 erläutert worden ist, werden die Bipolartransistoren T1 und T2 mit unterschiedlichen Stromdichten betrieben. Insbesondere entspricht die Emitterfläche A_{E2} des Bipolartransistors T2 einem Vielfachen der Emitterfläche A_{E1} des Bipolartransistors T1. Ebenso entspricht der Kollektorstrom I_{C1} des Bipolartransistors T1 in der Regel einem Vielfachen des Kollektorstroms I_{C2} des Bipolartransistors T2.

[0023] Unter den zuvor genannten Voraussetzungen kann allgemein die an der gemeinsamen Basis der Bipolartransistoren T1 und T2 bei der in Figur 2 gezeigten bekannten Referenzspannungsschaltung abgegriffene Spannung U abhängig von dem Widerstandsverhältnis $R1:R2$, dem Kollektorstromverhältnis $I_{C1}:I_{C2}$ und dem Emitterflächenverhältnis $A_{E2}:A_{E1}$ wie folgt berechnet werden:

$$U = U_T \frac{R_1}{R_2} \left(1 + \frac{I_{C1}}{I_{C2}}\right) \ln \frac{I_{C1} A_{E2}}{I_{C2} A_{E1}} + U_T \ln \frac{I_{C1}}{I_S}$$

[0024] Dabei bezeichnet U_T die Temperaturspannung und I_S den Sperrstrom der Bipolartransistoren. Wie aus der obigen Gleichung ersichtlich ist, kann die Referenzspannung auch durch Verändern des Kollektorstromverhältnisses $I_{C1}:I_{C2}$ kalibriert werden. Wird davon ausgegangen, daß der Kollektorstrom I_{C1} ausgehend von einem voreingestellten Wert I_{C1}' verändert wird, ergibt sich:

$$I_{C1} = I_{C1}'(1+k)$$

[0025] Für kleine Abgleichschritte ($k \leq 6\%$) kann unter Vernachlässigung quadratischer Terme und unter Anwendung der Vereinfachung $\ln(1+k) = k$ umgeschrieben werden in:

$$U = U' \left(1 + k \frac{U_T}{U'} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \left(1 + \frac{I_{C1}'}{I_{C2}} \left(1 + \ln \frac{I_{C1}' A_{E2}}{I_{C2} A_{E1}}\right)\right)\right)\right)$$

wobei U' die ursprüngliche, d. h. voreingestellte Referenzspannung bezeichnet und durch folgenden Ausdruck wiedergegeben werden kann:

$$U' = U_T \frac{R_1}{R_2} \left(1 + \frac{I_{C1}'}{I_{C2}}\right) \ln \frac{I_{C1}' A_{E2}}{I_{C2} A_{E1}} + U_T \ln \frac{I_{C1}'}{I_S}$$

5 [0026] Es gilt somit der lineare Zusammenhang:

$$U = U'(1+kC),$$

wobei die Konstante C ausgedrückt werden kann durch

$$C = \frac{U_T}{U'} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \left(1 + \frac{I_{C1}'}{I_{C2}} \left(1 + \ln \frac{I_{C1}' A_{E2}}{I_{C2} A_{E1}}\right)\right)\right)$$

15 [0027] Die Konstante C nimmt bei der augenblicklich realisierten Schaltung bei Raumtemperatur einen Wert von etwa $C=0,5$ an. Um die Ausgangsspannung U um 3% zu ändern, wäre demnach eine Änderung des Kollektorstroms I_{C1} des Bipolartransistors T1 um 6% erforderlich.

20 [0028] Insgesamt ist aus den obigen Ausführungen ersichtlich, daß durch Verändern des Kollektorstromverhältnisses $I_{C1}:I_{C2}$ die von der Referenzspannungsschaltung gelieferte Referenzspannung abgeglichen werden kann. Diese Erkenntnis macht sich die vorliegende Erfindung zu nutzen.

25 [0029] Figur 1 zeigt ein detailliertes Schaltbild eines bevorzugten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Referenzspannungsschaltung, bei der durch äußere Trimmaßnahmen das Verhältnis des dabei eingesetzten Stromspiegels verzogen wird, um das Kollektorstromverhältnis $I_{C1}:I_{C2}$ zu verändern. Insbesondere ist in Figur 1 eine in Automobilapplikationen (z. B. Airbag) implementierte Referenzspannungsschaltung dargestellt.

30 [0030] Auch bei der in Figur 1 gezeigten Referenzspannungsschaltung ist ein miteinander gekoppeltes Transistorpaar T1 und T2a vorhanden, wobei die Emitterfläche des Transistors T2a ein Vielfaches der Emitterfläche des Transistors T1 beträgt. Den Kollektoren dieser Transistoren werden Kollektorströme I_{C1} bzw. I_{C2a} zugeführt. Die Emitter der beiden Bipolartransistoren sind über eine Widerstandsschaltung mit Widerständen R1 und R2 miteinander gekoppelt. Die an der gemeinsamen Basis der Bipolartransistoren T1 und T2a anliegende Basisspannung wird abgegriffen und über einen Spannungsteiler bestehend aus Widerständen R4 und R5 hochmultipliziert, so daß abhängig von der Basisspannung U die gewünschte Ausgangs- bzw. Referenzspannung U_{ref} ausgegeben werden kann. Die an der gemeinsamen Basis der mit unterschiedlichen Stromdichten betriebenen Bipolartransistoren T1 und T2a anliegende Spannung entspricht der Summenspannung aus der Basis-Emitter-Spannung des Transistors T1 und der am Knotenpunkt zwischen den Widerständen R1 und R2 anliegenden Spannung, welche wiederum von der Differenz zwischen der Basis-Emitter-Spannung des Transistors T1 und der Basis-

Emitter-Spannung des Transistors T2a abhängt.

[0031] Des weiteren können über die Widerstände R1 und R2 die Arbeitsströme der Referenzspannungsschaltung eingestellt werden. Durch das Hochmultiplizieren bzw. Aufstocken der Basisspannung U des Bipolartransistors T1 mit Hilfe des Spannungsteilers R4, R5 ist die Referenzspannungsschaltung in der Lage, sich selbst zu speisen und der Versorgungsspannungsdurchgriff wird vernachlässigbar klein. Insgesamt entspricht insoweit die Funktionsweise der in Figur 1 gezeigten Referenzspannungsschaltung der Funktionsweise der in Figur 2 gezeigten bekannten Referenzspannungsschaltung.

[0032] Wie bereits erläutert worden ist, wird jedoch gemäß der vorliegenden Erfindung mindestens einer der Kollektorströme I_{C1} bzw. I_{C2a} verändert, um die von der Referenzspannungsschaltung gelieferte Referenzspannung U_{ref} gewünscht abgleichen zu können. Dies erfolgt insbesondere durch eine Veränderung des Spiegelungs- bzw. Umsetzverhältnisses des auch bei der bekannten Referenzspannungsschaltung von Figur 2 verwendeten Stromspiegels.

[0033] Gemäß Figur 1 sind allerdings zwei Stromspiegelschaltungen vorhanden. Der erste Stromspiegel umfaßt Bipolartransistoren T3-T5 und entspricht im wesentlichen dem in Figur 2 verwendeten Stromspiegel. Der zweite Stromspiegel umfaßt Bipolartransistoren T6-T8. Des weiteren ist ein weiterer Bipolartransistor T2b vorgesehen, der insbesondere baugleich zu dem Bipolartransistor T2a ausgebildet ist. Die Stromspiegel mit den Bipolartransistoren T3-T5 bzw. T6-T8 sind derart angeordnet, daß sie über die Vielfachtransistoren T2a und T2b zueinander parallel geschaltet sind. Die Emitterflächen der beiden Transistoren T2a und T2b sind gleich groß, so daß die von den beiden Stromspiegeln gelieferten Grundströme I_{C2a} bzw. I_{C2b} identisch sind.

[0034] Gemäß der in Figur 1 gezeigten Ausgestaltung bleibt auch während des Abgleichs der Referenzspannungsschaltung das Spiegelungsverhältnis des zweiten Stromspiegels mit den Transistoren T6-T8 konstant, d. h. es wird durch einen entsprechenden Abgleich lediglich auf das Spiegelungsverhältnis der ersten Stromspiegelschaltung mit den Bipolartransistoren T3-T5 eingewirkt. Dies erfolgt folgendermaßen.

[0035] Die an dem Ausgangsanschluß der Referenzspannungsschaltung anliegende Ausgangsspannung U_{ref} kann über Abgleichanschlüsse Z_P , Z_{1N} und Z_{2N} abgeglichen bzw. kalibriert werden. Zu diesem Zweck werden wiederum "Zapping"-Dioden Z1-Z3 verwendet, welche durch die in Figur 1 gezeigten Bipolartransistoren mit kurzgeschlossener Basis-Kollektor-Strecke gebildet sind und jeweils einen der Abgleichanschlüsse Z_P , Z_{1N} und Z_{2N} mit dem Abgleich-Masseanschluß Z_{GND} verbinden. Durch Anlegen einer bestimmten hohen Abgleichspannung an einen dieser Abgleichanschlüsse wird die entsprechende "Zapping"-Diode zum Durchbruch gebracht, so daß zwischen der Basis und

dem Emitter der entsprechenden "Zapping"-Diode eine niederohmige Verbindung entsteht, die eine entsprechende Ansteuerung von in Figur 1 gezeigten steuerbaren Schaltern in Form von p-Kanal-MOS-Feldeffekttransistoren zur Folge hat. Dabei sind gemäß Figur 1 beispielsweise die MOS-Feldeffekttransistoren M1-M3 und M8 dem Abgleichanschluß Z_P zugeordnet. Beim Anlegen der erforderlichen hohen Abgleichspannung an einen bestimmten der Abgleichanschlüsse werden die diesem Abgleichanschluß zugeordneten MOS-Feldeffekttransistoren derart durch die an dem jeweiligen Abgleichanschluß entsprechende niederohmige Verbindung der jeweiligen "Zapping"-Diode geschaltet, daß eine bestimmte dem jeweiligen Abgleichanschluß zugeordnete Strommenge von den Kollektorstrompfaden der Bipolartransistoren T1 oder T2a in Form der in Figur 1 gezeigten Abzweigströme I_{calP} bzw. I_{calN} abgezweigt wird, was eine entsprechende Verfälschung des Spiegelungsverhältnisses des Stromspiegels mit den Bipolartransistoren T3-T5 zur Folge hat, so daß die Referenzspannungsschaltung innerhalb bestimmter Grenzen kalibriert werden kann, um eine gewünschte Ausgangsspannung U_{ref} zu erzielen.

[0036] Die in Figur 1 gezeigte Referenzspannungsschaltung ist insbesondere derart dimensioniert, daß durch Anlegen einer Abgleichspannung an den Abgleichanschluß Z_P eine Erhöhung der Ausgangsspannung U_{ref} erzielt werden kann, während durch Anlegen einer Abgleichspannung an die Abgleichanschlüsse Z_{1N} bzw. Z_{2N} eine Verringerung der Ausgangsspannung U_{ref} um verschiedene Beträge herbeigeführt werden kann. Insbesondere ist die in Figur 1 gezeigte Referenzspannungsschaltung derart dimensioniert, daß die Ausgangsspannung innerhalb eines maximalen Kalibrierbereichs von $\pm 3\%$ verändert werden kann. Wie der zuvor beschriebenen Formel für die Konstante C entnommen werden kann, ist für eine derartige Veränderung der Ausgangsspannung eine Veränderung des Kollektorstroms I_{C1} des Bipolartransistors T1 um 6% erforderlich. Insbesondere ist die in Figur 1 gezeigte Referenzspannungsschaltung derart dimensioniert, daß durch Anlegen einer hohen Abgleichspannung zwischen die Anschlüsse Z_P und Z_{GND} eine Anhebung der Referenzspannung U_{ref} um +3% erzielt wird. Hingegen beträgt der über den Abgleichanschluß Z_{1N} erzielbare Abgleichschritt -1% und der über den Abgleichanschluß Z_{2N} erzielbare Abgleichschritt -2%. Durch eine gegebenenfalls gemeinsame Ansteuerung der Abgleichanschlüsse Z_P , Z_{1N} und Z_{2N} ist auf diese Weise ein additiver Abgleich der Ausgangsspannung U_{ref} zwischen -3% und +3% in 1%-Schritten möglich.

[0037] In Figur 1 ist der Abgleichanschluß Z_P über eine Steuerschaltung bestehend aus einem Widerstand R12, zwei p-Kanal-MOS-Feldeffekttransistoren M15 und M16 sowie zwei Invertern mit dem ersten steuerbaren MOS-Feldeffekttransistor M8 verbunden. Diese

Steuerschaltung ist über einen Anschluß I_P aktivierbar und verbindet den Gate-Anschluß des MOS-Feldeffekttransistors M8 auf vordefinierte Art und Weise mit der "Zapping"-Diode Z1. Entsprechende Steuerschaltungen sind auch für die weiteren Abgleichanschlüsse Z_{1N} und Z_{2N} vorgesehen, jedoch der Übersichtlichkeit halber nicht in Figur 1 dargestellt.

[0038] Bei Aktivierung des Abgleichanschlusses Z_P infolge eines Durchbruchs der "Zapping"-Diode Z1 wird der MOS-Feldeffekttransistor M8 leitend geschaltet und ein bestimmter Strom I_{3a} über einen weiteren Bipolartransistor T9 aus dem zweiten Stromspiegel (Bipolartransistoren T6-T8) ausgekoppelt. Dieser ausgekoppelte Strom I_{3a} wird den MOS-Feldeffekttransistoren M1-M3 zugeführt und führt dazu, daß aus dem Kollektorstrompfad des Bipolartransistors T2a ein bestimmter Abgleichstrom I_{calP} abgezweigt wird, der sich auf die beiden MOS-Feldeffekttransistoren M2 und M3 in Form der in Figur 1 gezeigten Ströme I_{cal1P} und I_{cal2P} aufteilt. Auf diese Weise wird das Spiegelungsverhältnis des Stromspiegels mit den Bipolartransistoren T3-T5 definiert verzogen und die Stromdichte des Bipolartransistors T2a reduziert, was entsprechend eine Erhöhung der am Knotenpunkt zwischen den Widerständen R1 und R2 abgegriffenen Differenzspannung zur Folge hat, so daß die gewünschte 3%-Erhöhung der Ausgangsspannung U_{ref} erreicht werden kann.

[0039] Auf analoge Weise kann durch Anlegen einer entsprechenden Abgleichspannung an die Abgleichanschlüsse Z_{1N} bzw. Z_{2N} ein vordefinierter Strom I_{3b} bzw. I_{3c} über den Transistor T9 ausgekoppelt und den MOS-Feldeffekttransistoren M4 und M5 bzw. M6 und M7 zugeführt werden, so daß ein vordefinierter Abgleichstrom I_{calN} in diesem Fall jedoch von dem Kollektorstrompfad des Bipolartransistors T1 abgezweigt wird. Dieser Abgleichstrom I_{calN} wird in Form der in Figur 1 gezeigten Ströme I_{cal1N} bzw. I_{cal2N} über die entsprechend leitend geschalteten MOS-Feldeffekttransistoren M5 bzw. M7 abgeführt und führt zu einer definierten Verringerung der Kollektorstromdichte des Bipolartransistors T1, so daß entsprechend die am Knotenpunkt zwischen den Widerständen R1 und R2 anliegende Differenzspannung verringert wird, was eine wiederum entsprechende Reduzierung der am Ausgangsanschluß der Referenzspannungsschaltung ausgegebenen Referenzspannung U_{ref} zur Folge hat.

[0040] Mit Hilfe der MOS-Feldeffekttransistoren M8-M10 sind andererseits die Abgleichströme I_{calP} bzw. I_{calN} sowie die ausgekoppelten Ströme I_{3a} - I_{3c} ausgeschaltet, falls keine Abgleichspannung an einem der Anschlüsse Z_P , Z_{1N} , Z_{2N} anliegt, so daß der Einfluß der Kalibrierschaltung in diesem Fall gleich Null ist. Dies gilt jedoch im Hochtemperaturbereich nur dann, wenn sichergestellt ist, daß die Draingebiete der MOS-Feldeffekttransistoren M2 und M3 denen der MOS-Feldeffekttransistoren M5 und M7 entsprechen, da sich dann die thermisch bedingten Drain-Bulk-Leckströme gegensei-

tig kompensieren und bei $I_{calP}=I_{calN}\neq 0$ die Ausgangsspannung U_{ref} nicht beeinflusst wird. Insbesondere hinsichtlich der Linearität der Abgleichschritte ist es vorteilhaft, einerseits die Transistoren M5 und M2 sowie andererseits die Transistoren M7 und M3 entsprechend zu dimensionieren.

[0041] Aus den zuvor genannten Gründen ist gemäß Figur 1 am Kollektor und an der Basis des Bipolartransistors T1 ein Dummy-Transistor T15 angeschlossen, wobei jedoch auch der Anschluß mehrerer gemäß Figur 1 verschalteter Dummy-Transistoren T15 möglich ist. Vorteilhafterweise ist die Kollektorwanne des Bipolartransistors T1 genauso groß ausgestaltet wie die des Vielfachtransistors T2a/b, so daß die erhöhten Kollektor-Substrat- bzw. Kollektor-Basis-Generationsströme des größeren Vielfachtransistors T2a/b durch die Transistoren T1 und T15 kompensiert werden.

[0042] Zudem ist bei dem in Figur 1 gezeigten bevorzugten Ausführungsbeispiel ein baugleiches pnp-Bipolartransistorpaar T13, T14 vorgesehen, mit deren Hilfe die thermischen Leckströme der pnp-Bipolartransistoren T5 und T8 der beiden Stromspiegel aufgehoben werden, wobei die Basis der pnp-Bipolartransistoren T5 und T8 jeweils der Epiwanne entspricht. Um zudem den Einfluß der prozeßbedingten Stromverstärkungsschwankungen über die Basisströme dieser pnp-Bipolartransistoren zu eliminieren, werden alle diese Bipolartransistoren vorteilhafterweise über die in Figur 1 gezeigten Ströme I_{5a} - I_{5c} mit in etwa derselben Stromdichte betrieben. Wie in Figur 1 entnommen werden kann, werden diese Ströme I_{5a} - I_{5c} über eine Schaltung mit p-Kanal-MOS-Feldeffekttransistoren M11-M14 über einen Strom I_4 ebenfalls von dem Strom I_{C2b} abgeleitet, was automatisch mit den Spannungsabfällen an den in Figur 1 gezeigten Bauteilen T11, R11 und T12 eine geeignete Einstellung der Basisspannung der Bipolartransistoren T13 und T14 bewirkt. Die Kollektorspannungen der Bipolartransistoren T4 bzw. T7 liegen somit eine Diodenflußspannung tiefer als deren Basisspannungen, was die Early-Effekte der beiden Stromspiegelschaltungen im Arbeitspunkt der Referenzspannungsschaltung kompensiert. Des weiteren kann auf diese Weise eine eventuelle Sättigung der pnp-Bipolartransistoren T4 und T7 sowie des npn-Bipolartransistors T1 vermieden werden.

[0043] Schließlich werden die n-Epi-Wannen der einzelnen p-Diffusionswiderstände vorzugsweise an die positive Versorgungsspannung V_{CC} angeschlossen, um den bei hohen Temperaturen nicht zu vernachlässigenden Einfluß der Wannenleckströme an den Basis-Diffusionswiderständen auf die Funktion der Referenzspannungsschaltung zu unterbinden.

[0044] Die zudem in Figur 1 dargestellten Widerstände R6-R11 dienen insbesondere zur Voreinstellung der beiden Stromspiegel, während der Bipolartransistor T10 im wesentlichen dem bereits in Figur 2 gezeigten Transistor T10 entspricht und als Stellglied für den Ausgangsanschluß der Referenzspannungsschaltung vor-

gesehen ist, um die Ausgangsspannung U_{ref} selbst bei Belastung mit ungleichmäßiger Last konstant zu regeln.

Bezugszeichenliste

[0045]

T1-T23	Bipolartransistor	
M1-M16	MOS-Feldeffekttransistor	
R1-R13	Widerstand	10
D1-D3	Diode	
Z1-Z3	"Zapping"-Diode	
I_0	Stromquelle	
V_{cc}	Versorgungsspannung	
I_P , Z_P , Z_{1N} , Z_{2N} , Z_{GND}	Steueranschluß	15

Patentansprüche

1. Referenzspannungsschaltung,

mit einer Bipolartransistorschaltung (T1, T2a, T2b), welche eine Referenzspannung (U_{ref}) liefert, welche von einer Summenspannung aus einer ersten Spannung und einer zweiten Spannung abgeleitet ist, wobei die erste Spannung aus der Flußspannung eines stromdurchflossenen pn-Übergangs und die zweite Spannung aus der Differenzspannung zweier Flußspannungen entsprechender stromdurchflossener pn-Übergänge abgeleitet ist, und mit Abgleichmitteln (Z1-Z3, M1-M10) zum Abgleichen der von der Bipolartransistorschaltung (T1, T2a, T2b) gelieferten Referenzspannung (U_{ref}),

dadurch gekennzeichnet,

daß die Abgleichmittel (Z1-Z3, M1-M10) derart ausgestaltet und angeordnet sind, daß sie bei entsprechender Aktivierung den Kollektorstrom (IC1, IC2a) mindestens eines Bipolartransistors (T1, T2a) der Bipolartransistorschaltung verändern.

2. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die Bipolartransistorschaltung einen ersten Bipolartransistor (T1) und einen zweiten Bipolartransistor (T2a) umfaßt, daß dem Kollektor des ersten Bipolartransistors (T1) ein erster Kollektorstrom (IC1) und dem Kollektor des zweiten Bipolartransistors (T2a) ein zweiter Kollektorstrom (IC2a) zugeführt wird, wobei der erste Bipolartransistor und der zweite Bipolartransistor derart ausgestaltet und die ersten und zweiten Kollektorströme derart bemessen sind, daß der erste Bipolartransistor und der zweite Bipolartransistor mit unterschiedlichen Stromdichten durch-

flossen werden,

daß die Basis des ersten Bipolartransistors (T1) mit der Basis des zweiten Bipolartransistors (T2a) verbunden ist,

daß der Emitter des ersten Bipolartransistors (T1) derart über eine Widerstandsschaltung (R1, R2) mit dem Emitter des zweiten Bipolartransistors (T2a) gekoppelt ist, daß an der Basis des ersten Bipolartransistors die Referenzspannung (U_{ref}) abgegriffen werden kann, wobei die erste Spannung der Basis-Emitter-Spannung des ersten Bipolartransistors entspricht und die zweite Spannung von der Differenz der Basis-Emitter-Spannungen des ersten und zweiten Bipolartransistors abhängt, und daß die Abgleichmittel (Z1-Z3, M1-M10) derart ausgestaltet und angeordnet sind, daß sie bei entsprechender Aktivierung den ersten Kollektorstrom (IC1) und/oder den zweiten Kollektorstrom (IC2a) des ersten bzw. zweiten Bipolartransistors (T1, T2a) verändern.

3. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die Abgleichmittel (Z1-Z3, M1-M10) derart ausgestaltet und angeordnet sind, daß sie bei entsprechender Aktivierung einen ersten Abgleichstrom (IcalN) von dem ersten Kollektorstrom (IC1) und/oder einen zweiten Abgleichstrom (IcalP) von dem zweiten Kollektorstrom (IC2a) abzweigen.

4. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die Abgleichmittel (Z1-Z3, M1-M10) mehrere Anschlüsse umfassen, die über eine steuerbare Schalter (M1-M10) aufweisende Steuerschaltung mit den Kollektoren des ersten und zweiten Bipolartransistors (T1, T2a) gekoppelt sind, wobei bei Anlegen einer entsprechenden Abgleichspannung an einen der Anschlüsse jeweils ein anderer erster oder zweiter Abgleichstrom (IcalN, IcalP) von dem ersten oder zweiten Kollektorstrom (IC1, IC2a) abgezweigt wird.

5. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die Abgleichmittel (Z1-Z3, M1-M10) drei Anschlüsse umfassen, wobei die Steuerschaltung (M1-M10) derart aufgebaut ist, daß bei Anlegen einer ersten Abgleichspannung ein so großer zweiter Abgleichstrom (IcalP) von dem zweiten Kolle-

torstrom (IC2a) abgezweigt wird, daß sich die Referenzspannung (U_{ref}) um 3% erhöht, während bei Anlegen einer Abgleichspannung an den zweiten bzw. dritten Anschluß ein so großer erster Abgleichstrom (I_{calN}) von dem ersten Kollektorstrom (IC1) abgezweigt wird, daß die Referenzspannung (U_{ref}) um 1% bzw. 2% absinkt.

6. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die Anschlüsse der Abgleichmittel (Z1-Z3, M1-M10) mit Dioden (Z1-Z3) gekoppelt sind, welche bei Anlegen der entsprechenden Abgleichspannung in Sperrichtung durchbrechen und dadurch entsprechende steuerbare Schalter (M1-M10) der Steuerschaltung der Abgleichmittel ansteuern.

7. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die steuerbaren Schalter (M1-M10) durch MOS-Feldeffekttransistoren realisiert sind.

8. Referenzspannungsschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch**

eine Stromspiegelschaltung (T3-T5), welche Kollektorströme (IC1, IC2a) für die Bipolartransistoren (T1, T2a) der Bipolartransistorschaltung erzeugt, wobei die Abgleichmittel (Z1-Z3, M1-M10) derart angeordnet und ausgestaltet sind, daß sie bei entsprechender Aktivierung das Übersetzungsverhältnis der Stromspiegelschaltung (T3-T5) verändern.

9. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 8 und einem der Ansprüche 2 bis 7, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die Bipolartransistorschaltung einen dritten Bipolartransistor (T2b) umfaßt, welcher wesensgleich zu dem zweiten Bipolartransistor (T2a) ist, und daß eine weitere Stromspiegelschaltung (T6-T8) derart mit dem dritten Bipolartransistor (T2b) gekoppelt ist, daß die Stromspiegelschaltung (T3-T5) und die weitere Stromspiegelschaltung (T6-T8) über den zweiten Bipolartransistor (T2a) und den dritten Bipolartransistor (T2b) parallel geschaltet sind, wobei die Basis bzw. der Emitter des zweiten Bipolartransistors (T2a) mit der Basis bzw. dem Emit-

ter des dritten Bipolartransistors (T2b) verbunden ist.

10. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die beiden Stromspiegelschaltungen (T3-T5; T6-T8) derart ausgestaltet sind, daß der zweite und dritte Bipolartransistor (T2a, T2b) mit derselben Stromdichte durchflossen werden.

11. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 9 oder 10 und einem der Ansprüche 4 bis 7, **dadurch gekennzeichnet,**

daß die Anschlüsse der Abgleichmittel (Z1-Z3, M1-M10) über steuerbare Schalter (M8-M10) der Steuerschaltung (M1-M10) mit der weiteren Stromspiegelschaltung (T6-T8) gekoppelt sind,

wobei bei Anlegen der entsprechenden Abgleichspannung an einen der Anschlüsse ein entsprechender steuerbarer Schalter (M8-M10) derart aktiviert wird, daß ein dem jeweiligen Anschluß entsprechender bestimmter Steuerstrom (I3a-I3c) abgezweigt wird, wobei der abgezweigte Steuerstrom (I3a-I3c) seinerseits zu einer Aktivierung eines entsprechenden steuerbaren Schalters (M2, M3, M5, M7) der Steuerschaltung derart führt, daß der gewünschte erste bzw. zweite Abzweigstrom (I_{calN} , I_{calP}) von dem ersten bzw. zweiten Kollektorstrom (IC1, IC2a) abgezweigt wird.

12. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet,**

daß der erste Abzweigstrom (I_{calN}) über zwei parallel geschaltete steuerbare Schalter (M5, M7) geführt wird,

wobei die parallel geschalteten steuerbaren Schalter (M5, M7) durch unterschiedliche von der zweiten Stromspiegelschaltung (T6-T8) abgezweigte Steuerströme (I3b, I3c) aktivierbar sind.

13. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet,**

daß der zweite Abzweigstrom (I_{calP}) über zwei parallel geschaltete steuerbare Schalter (M2, M3) geführt wird, welche beide durch denselben von der weiteren Stromspiegelschaltung (T6-T8) abgezweigten Steuerstrom (I3a) aktivierbar sind.

14. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 12

und 13,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Drainanschlüsse der für den ersten Abzweigstrom (IcalN) vorgesehenen steuerbaren Schalter (M5, M7) und der für den zweiten Abzweigstrom (IcalP) vorgesehenen steuerbaren Schalter (M2, M3) miteinander verbunden sind.

15. Referenzspannungsschaltung nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,

daß jeweils einer der für den ersten Abzweigstrom (IcalN) vorgesehenen steuerbaren Schalter (M5, M7) identisch zu einem der für den zweiten Abzweigstrom (IcalP) vorgesehenen steuerbaren Schalter (M2, M3) ausgebildet ist.

16. Referenzspannungsschaltung nach einem der Ansprüche 9 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,

daß ein vierter Bipolartransistor (T5) mit seiner Basis an die Basis des ersten Bipolartransistors (T1) und mit seinem Emitter sowie seinem Kollektor an den Kollektor des ersten Bipolartransistors (T1) angeschlossen ist.

17. Referenzspannungsschaltung nach einem der Ansprüche 9 bis 16,
dadurch gekennzeichnet,

daß der erste Bipolartransistor (T1) eine Kollektorwanne besitzt, welche im wesentlichen genauso groß wie die Kollektorwanne des zweiten und dritten Bipolartransistors (T2a, T2b) ausgebildet ist.

18. Referenzspannungsschaltung nach einem der Ansprüche 9 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Stromspiegelschaltung (T3-T5) und die weitere Stromspiegelschaltung (T6-T8) jeweils zwei mit einem entsprechenden Ausgang der jeweiligen Stromspiegelschaltung gekoppelte Bipolartransistoren (T3, T4; T6, T7) sowie einen an einen gemeinsamen Basisanschluß dieser beiden Bipolartransistoren (T3, T4; T6, T7) angeschlossenen pnp-Bipolartransistor (T5, T8) umfassen, und daß parallel zu den pnp-Bipolartransistoren (T5, T8) mindestens ein weiterer pnp-Bipolartransistor (T13, T14) geschaltet ist, wobei die Stromspiegelschaltungen (T3-T5; T6-T8) der-

art ausgestaltet sind, daß die pnp-Bipolartransistoren (T5, T8, T13, T14) mit identischen Stromdichten betrieben werden.

5 19. Referenzspannungsschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

daß n-Epi-Wannen der Bipolartransistoren der Referenzspannungsschaltung mit einem positiven Versorgungsspannungsanschluß Vcc verbunden sind.

10 20. Referenzspannungsschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

daß eine Spannungsteilerschaltung (R4, R5) vorgesehen ist, welche die von der Bipolartransistorschaltung (T1, T2a, T2b) gelieferte Referenzspannung (U_{ref}) hochmultipliziert.

25

30

35

40

45

50

55

FIG 1A

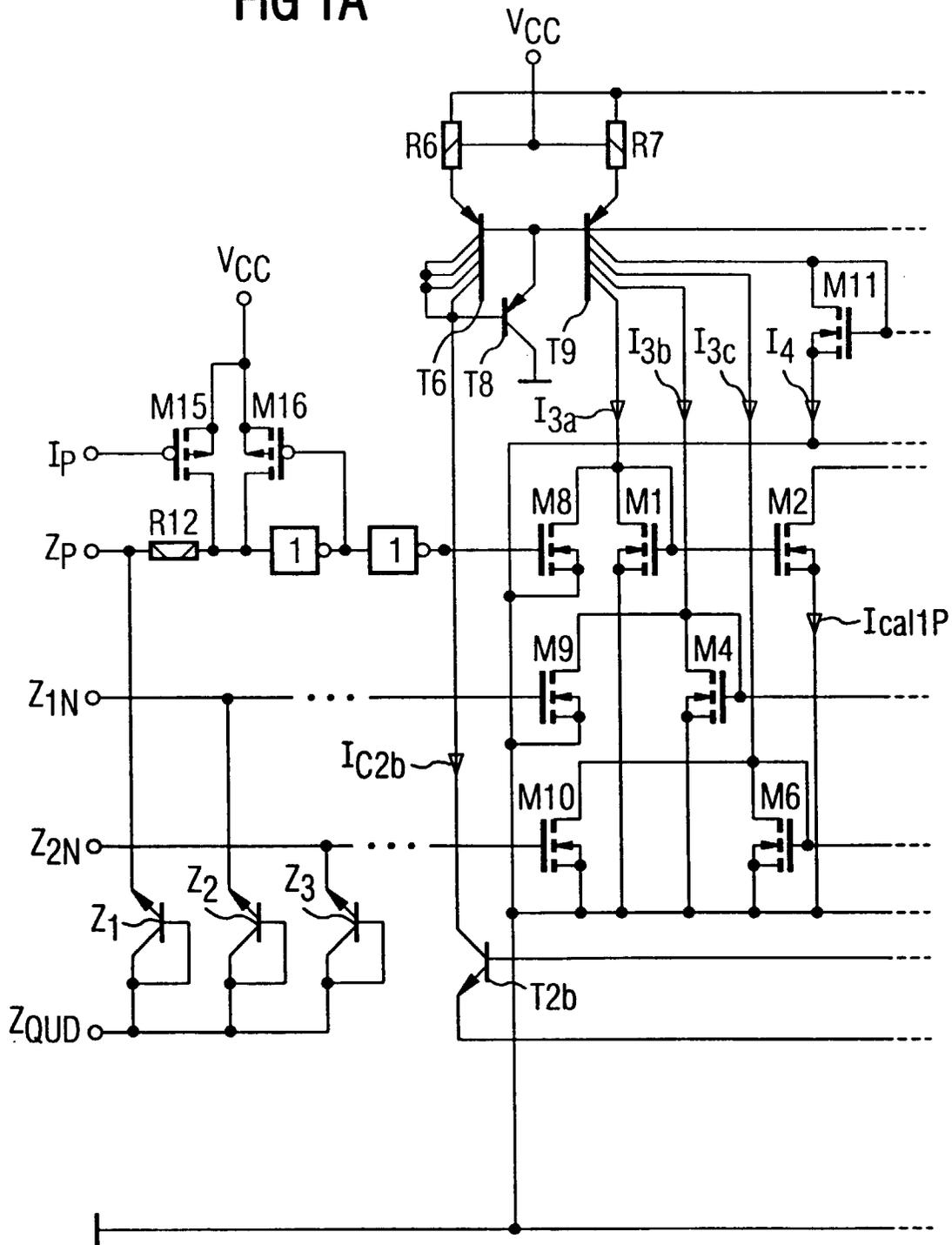


FIG 1B

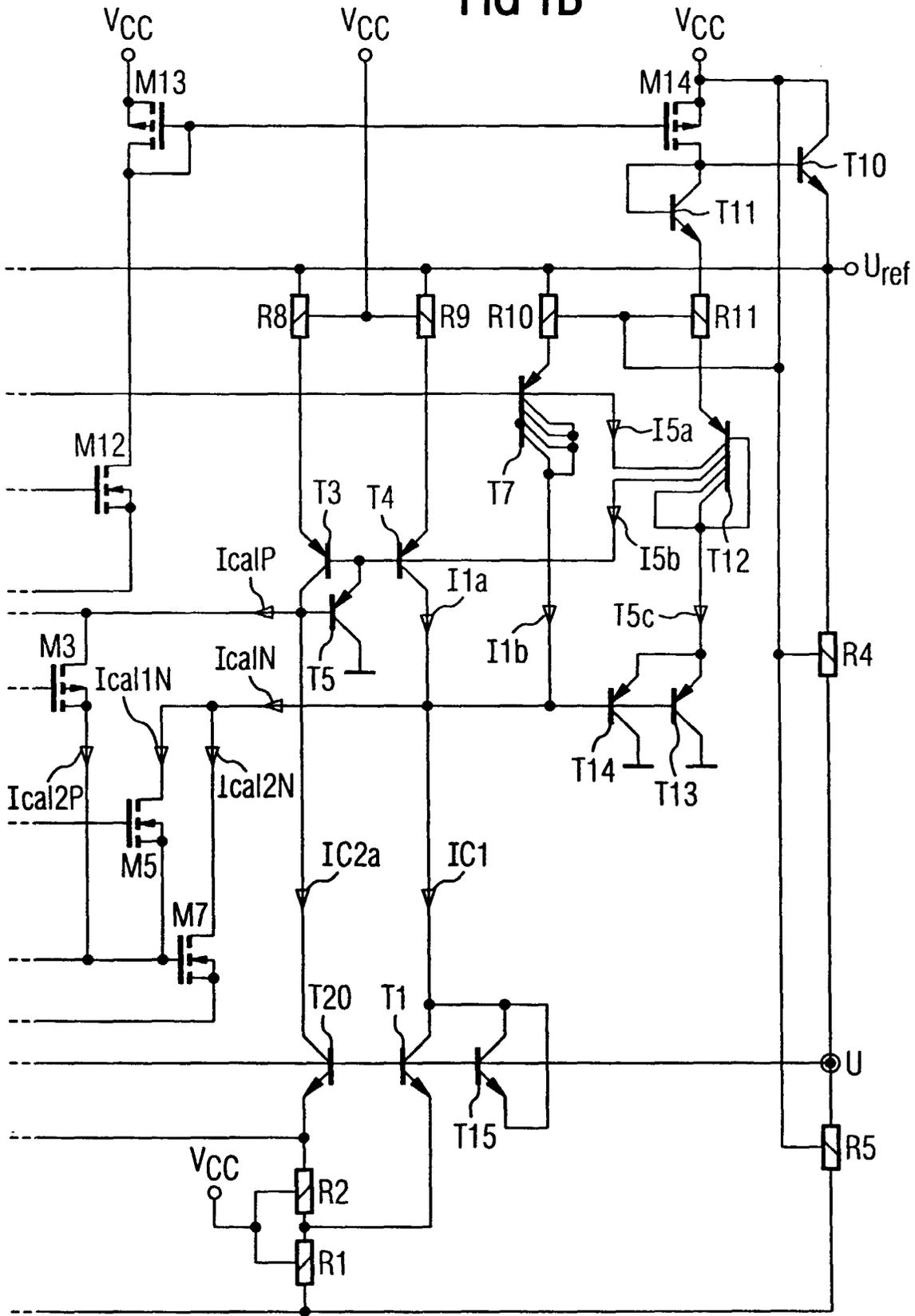


FIG 2
(Stand der Technik)

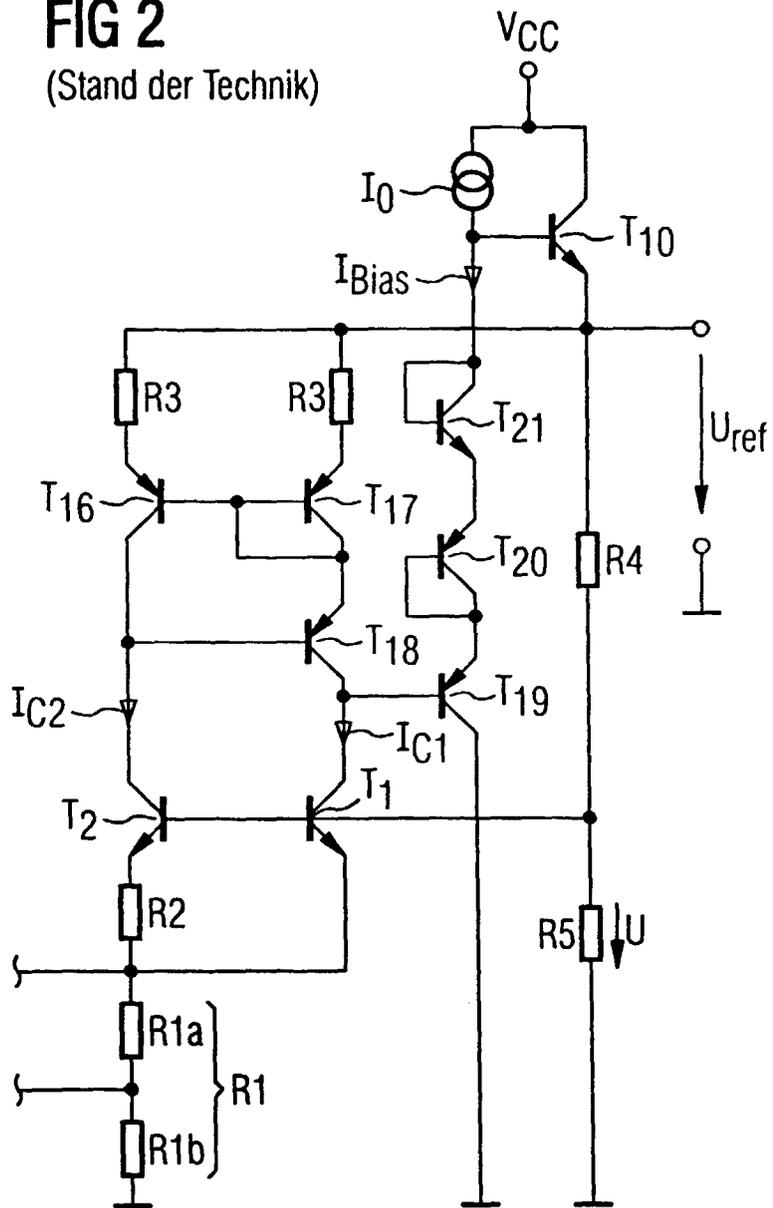


FIG 3
(Stand der Technik)

